

行业投资评级

强于大市 | 维持

行业基本情况

收盘点位	2116.63
52周最高	2116.63
52周最低	1420.7

行业相对指数表现（相对值）



资料来源：聚源，中邮证券研究所

研究所

分析师: 刘卓
SAC 登记编号: S1340522110001
Email: liuzhuo@cnpsec.com
分析师: 陈基赞
SAC 登记编号: S1340524070003
Email: chenjiyun@cnpsec.com
分析师: 虞洁攀
SAC 登记编号: S1340523050002
Email: yujiapan@cnpsec.com

近期研究报告

《固态电池系列专题：什么是等静压设备？》 - 2025.12.05

钻石散热专题

高效散热材料，商业化进程持续推进

● 投资要点

高功率电子器件热管理问题愈发严峻，散热会明显影响电子器件性能、寿命、安全性。近年来，随着电子器件遵循着摩尔定律逐步向集成化、高热流密度和微小型化的快速发展，其热管理问题正变得越来越严峻。以芯片为例，有效清除集成电路芯片产生的热量对保证系统的持续、稳定和平稳运行越来越重要，如果散热跟不上，不仅会影响性能，还可能缩短寿命甚至引发安全隐患。研究发现，电子元器件的可靠性对温度十分敏感，当电子元器件的工作温度达到 70~80℃后，温度每上升 1℃，其可靠性就会降低 5%。超过 55% 的电子设备失效的主要原因是温度过高。

金刚石热导率远高于其他材料，且具有优异的热扩散系数、良好的绝缘性与低介电常数。天然单晶金刚石在室温下的热导率高达 2000-2200W/(m*K)，是铜(约 400W/(m*K))的 5 倍，铝的 10 倍以上。这意味着热量能以极高的效率通过金刚石材料传递出去，显著降低芯片结温。同时，金刚石拥有极高的热扩散系数，使其能够迅速响应芯片局部热点的温度变化，避免热量淤积，这对于处理单元高度集中的 AI 芯片尤为重要。此外，金刚石是优良的电绝缘体，同时具有较低且稳定的介电常数。这使其在作为散热介质的同时，不会引入额外的寄生电容，对芯片高频电信号的完整性影响极小，契合 AI 芯片高频率运行的需求。

热沉片是当前金刚石散热重要应用方式。金刚石当前重要应用方式是作为“热沉”紧密贴合在产热核心之上，扮演高效的“热量搬运工”角色，其连接工艺包括直接连接、间接连接，其主要应用形式包括：衬底型热沉、帽盖型热沉。芯片内嵌与晶圆级集成更前沿的技术路线包括：在芯片制造阶段，将金刚石微通道或金刚石层通过晶圆键合技术，与硅芯片集成；或者在宽禁带半导体芯片上，外延生长金刚石层。在射频功率放大器和激光二极管领域，金刚石热沉已实现商业化应用，验证了其可靠性。

多种材料/制备方式齐头并进，技术尚未完全定型。目前金刚石热管理领域主要以单晶金刚石、金刚石铜及金刚石铝、金刚石/SiC 基板、金刚石微粉等体系为主，各自对应不同的应用场景和性能需求。以单晶金刚石为例，其导热率远高于其他材料，在高端电子器件散热中有着广阔的应用潜力，但要大规模应用仍有价格昂贵、接触界面传热效率等痛点，仍需在成本、加工和界面工程上不断突破。

AI 芯片领域，钻石散热潜在市场空间广阔。假设 2030 年全球 AI 芯片市场规模为 3 万亿人民币；AI 芯片中钻石散热方案渗透率分别为 5%、10%、20%、50%；钻石散热价值量占比分别为 5%、8%、10%，进行弹性测算，钻石散热市场空间的区间为 75 亿至 1500 亿。

相关上市公司：国机精工、沃尔德、四方达、力量钻石、惠丰钻石。

● **风险提示：**

钻石散热产业进展不及预期。

目录

1 钻石散热专题：高性能散热材料，商业化进程持续推进.....	5
1.1 金刚石：高性能散热材料，热导率出类拔萃.....	5
1.2 多种材料/制备方式齐头并进，技术尚未完全定型.....	7
1.3 潜在市场空间广阔，相关上市公司积极布局.....	13
2 风险提示.....	14

图表目录

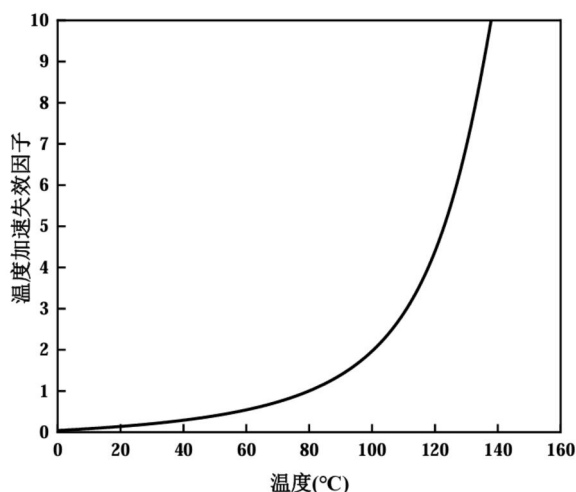
图表 1: GaN 芯片失效速率与温度的关系.....	5
图表 2: 温度为电子器件主要失效原因.....	5
图表 3: 金刚石与几类主要散热材料性能对比.....	6
图表 4: Akash 钻石冷却技术对于数据中心以及 GPU 的作用.....	7
图表 5: 金刚石与半导体的连接工艺.....	8
图表 6: 金刚石热沉片现有商业应用案例（高功率半导体激光器）.....	9
图表 7: 单晶金刚石图片.....	9
图表 8: HFCVD 加工方法.....	10
图表 9: MPCVD 加工方法.....	10
图表 10: 多晶金刚石图片.....	11
图表 11: 金刚石复合材料.....	12
图表 12: AI 芯片领域钻石散热市场空间弹性测算表.....	13
图表 13: 钻石散热相关上市公司介绍.....	14

1 钻石散热专题：高性能散热材料，商业化进程持续推进

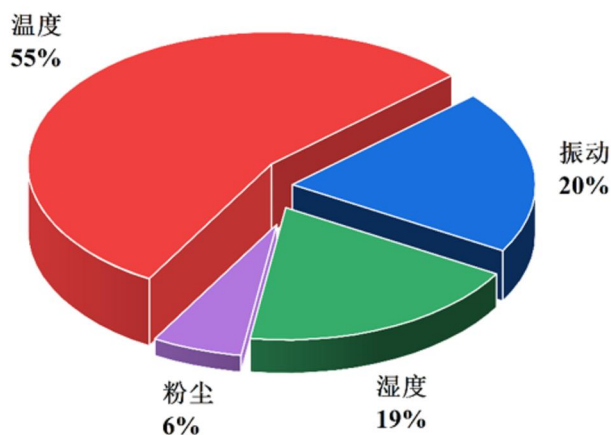
1.1 金刚石：高性能散热材料，热导率出类拔萃

高功率电子器件热管理问题愈发严峻，散热会明显影响电子器件性能、寿命、安全性。近年来，随着电子器件遵循着摩尔定律逐步向集成化、高热流密度和微型化的快速发展，其热管理问题正变得越来越严峻，譬如高性能 AI 芯片的功耗动辄超过 700W，热流密度可超过 $1\text{kW}/\text{cm}^2$ ；高功率 GaN/SiC 器件在电动汽车和数据中心应用中，热量集中且快速产生；光通信模块和激光器对散热均匀性、热响应速度有极高要求。以芯片为例，有效清除集成电路芯片（如 CPU 和 GPU）产生的热量对保证系统的持续、稳定和平稳运行越来越重要，如果散热跟不上，不仅会影响性能，还可能缩短寿命甚至引发安全隐患。研究发现，电子元器件的可靠性对温度十分敏感，当电子元器件的工作温度达到 $70\sim 80^\circ\text{C}$ 后，温度每上升 1°C ，其可靠性就会降低 5%。超过 55% 的电子设备失效的主要原因是温度过高。

图表1：GaN 芯片失效速率与温度的关系



图表2：温度为电子器件主要失效原因



资料来源：惠财鑫《三维堆叠 GaN 芯片多热源耦合及热管理技术》，中邮证券研究所

资料来源：方逸琳《高热流密度芯片散热微通道液冷设计及散热性能研究》，中邮证券研究所

金刚石，在散热应用上，其优势体现在多个维度：

(1)极高的热导率:天然单晶金刚石在室温下的热导率高达 2000-2200W/(m*K), 是铜(约 400W/(m*K))的 5 倍, 铝的 10 倍以上。这意味着热量能以极高的效率通过金刚石材料传递出去, 显著降低芯片结温。

(2)优异的热扩散系数:热扩散系数决定了材料内部热平衡建立的速度。金刚石拥有极高的热扩散系数, 使其能够迅速响应芯片局部热点的温度变化, 避免热量淤积, 这对于处理单元高度集中的 AI 芯片尤为重要。

(3)良好的绝缘性与低介电常数:金刚石是优良的电绝缘体, 同时具有较低且稳定的介电常数。这使其在作为散热介质的同时, 不会引入额外的寄生电容, 对芯片高频电信号的完整性影响极小, 契合 AI 芯片高频率运行的需求。高的机械强度与化学稳定性: 金刚石硬度极高, 耐磨耐腐蚀, 热膨胀系数低, 与常用半导体材料(如硅、氮化镓)匹配性相对较好, 能承受严苛的封装工艺和长期工作环境。

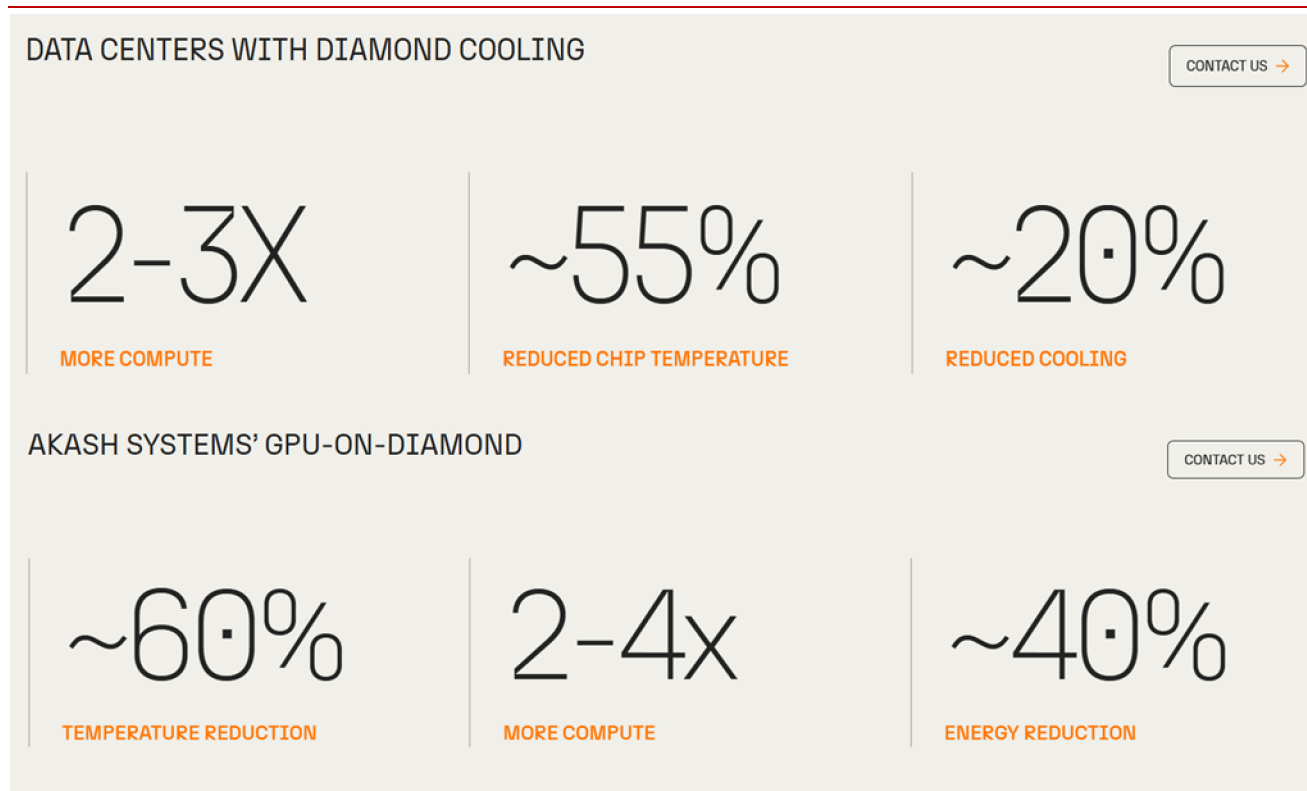
图表3: 金刚石与几类主要散热材料性能对比

材料	热导率 (W/(m·K))	热膨胀系数 ($10^{-6}/K$)	电绝缘性
单晶金刚石	2000-2200	~1.0	优
多晶金刚石薄膜	1000-1800	2.0-3.0	优
铜 (Cu)	~400	17.0	导体 (需绝缘处理)
铝 (Al)	~237	23.1	导体 (需绝缘处理)
氮化铝 (AlN)	~170-200	4.5	优

资料来源: 化合积电, 中邮证券研究所

Akash 声称其钻石冷却技术可以将 GPU 的热点温度降低 10 到 20 摄氏度, 为数据中心节省“数百万美元的冷却成本”, 同时防止热节流。在 GPU-on-diamond 特定幻灯片中, 还可以看到使用 Akash 技术可将温度降低高达 60%, 从而将能耗降低 40%的说法。

图表4: Akash 钻石冷却技术对于数据中心以及 GPU 的作用



资料来源: Akash 官网, 中邮证券研究所

1.2 多种材料/制备方式齐头并进, 技术尚未完全定型

金刚石并非直接替代芯片内部的硅, 而是作为“热沉”紧密贴合在产热核心之上, 扮演高效的“热量搬运工”角色, 其连接工艺包括直接连接、间接连接。其主要应用形式包括:

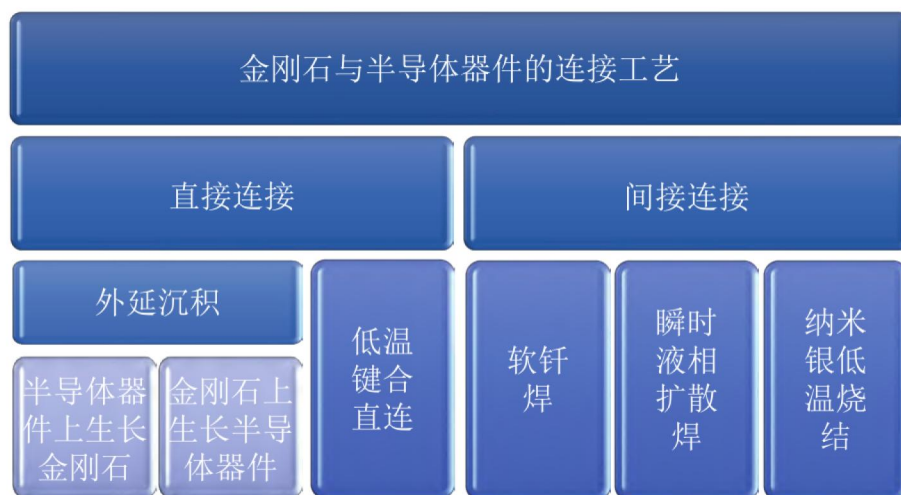
衬底型热沉: 将 AI 芯片直接倒装焊接在金刚石衬底上, 金刚石衬底替代了传统的有机或陶瓷基板, 芯片产生的热量通过焊点直接、垂直地导入下方的金刚石衬底, 再传导至外部散热器。这种方式热路径最短, 散热效率最高, 是解决核心区域热点最理想的方案。

帽盖型热沉: 在芯片封装完成后, 将一块加工成型的金刚石片(或金刚石-金属复合材料)作为顶盖, 通过导热界面材料贴合在芯片封装体的顶部, 这种方式可作为现有封装架构的增强方案, 改造相对灵活。

芯片内嵌与晶圆级集成更前沿的技术路线包括: 在芯片制造阶段, 将金刚石微通道或金刚石层通过晶圆键合技术, 与硅芯片集成; 或者在 GaN-on-SiC 等宽

禁带半导体芯片上，外延生长金刚石层。这属于“芯片级”的散热解决方案，代表着未来的发展方向。

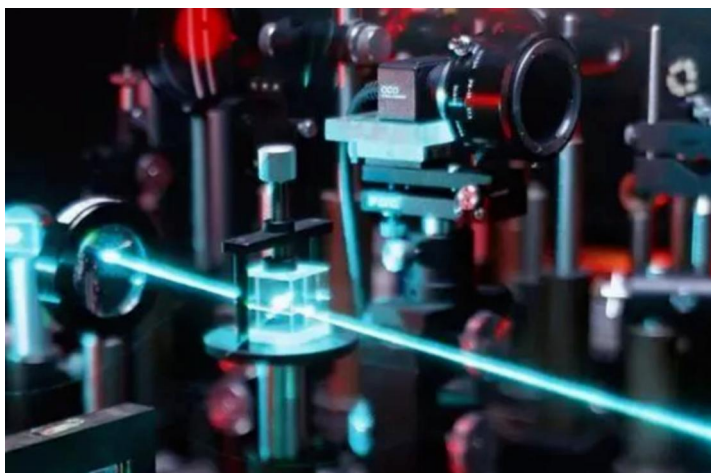
图表5：金刚石与半导体的连接工艺



资料来源：代文、林正得、易剑《金刚石热沉与半导体器件连接技术研究现状与发展趋势》，中邮证券研究所

在射频功率放大器和激光二极管领域，金刚石热沉已实现商业化应用，验证了其可靠性。以高功率半导体激光器为例，高功率半导体激光器具有电光效率高、易调制、体积小、重量轻等优点。热效应会降低激光器的输出功率、电光转换效率，甚至减少使用寿命。高功率半导体激光器封装对过渡热沉的要求主要有两个方面，低热阻与低热失配。根据傅里叶定律，激光器的热阻与热导率成反比关系，热沉材料的热导率越高，越可有效降低器件热阻。与使用 Cu 热沉的器件相比，一个厚度 350~400um，热导率在 12~14W/(K·cm) 间的金刚石膜热沉，可使其热阻降低 45~50%，光输出功率提高 25%。

图表6：金刚石热沉片现有商业应用案例（高功率半导体激光器）



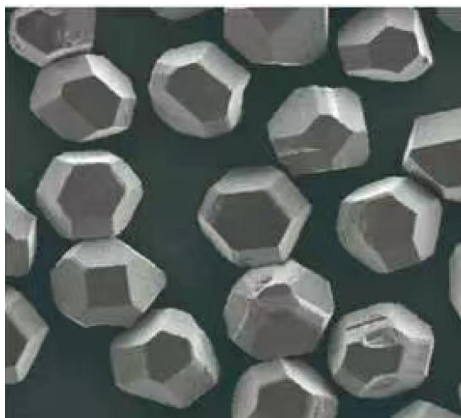
资料来源：化合积电，中邮证券研究所

目前金刚石热管理领域主要以单晶金刚石、金刚石铜及金刚石铝、金刚石/SiC 基板、金刚石微粉等体系为主，各自对应不同的应用场景和性能需求。

(1)单晶金刚石

单晶金刚石是潜力极高的散热材料。单晶金刚石的热导率高达 2000~2200W/(m*k)，远超其他散热材料，这种极高的导热能力意味着，单晶金刚石可以在极短时间内把芯片产生的热量传导出，显著降低器件的工作温度。除了导热率，单晶金刚石还有其他独特优势：电绝缘性高：天然绝缘材料，不会引入短路风险；硬度极高：机械强度高，耐磨损，适合复杂封装和精密加工；热稳定性优异：可耐高温环境，性能随温度变化小。

图表7：单晶金刚石图片



资料来源：超硬材料与磨具磨料，万磨金刚石，中邮证券研究所

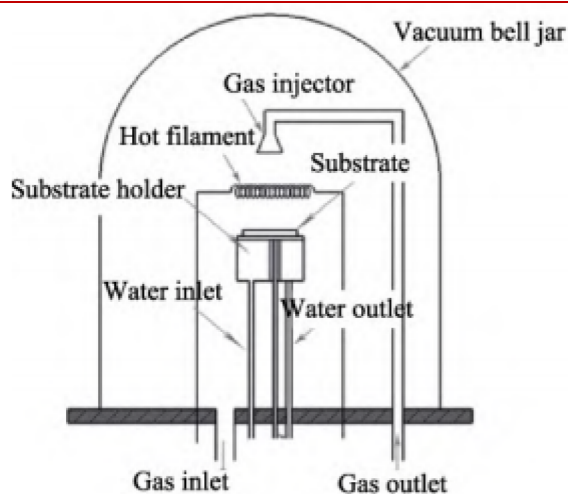
工业上主要有两种制备方式：

(1) 高温高压法 (HPHT): 模拟天然金刚石形成条件, 高温高压下生成单晶金刚石。该方法合成的晶体质量高、杂质少; 但是尺寸受限, 成本较高。

(2) 化学气相沉积法 (CVD): 通过气相反应在基底上沉积碳原子, 逐层生长出单晶金刚石膜。该技术可控制晶体厚度和尺寸, 适合批量制备; 但是设备和工艺要求高, 沉积速率较低。

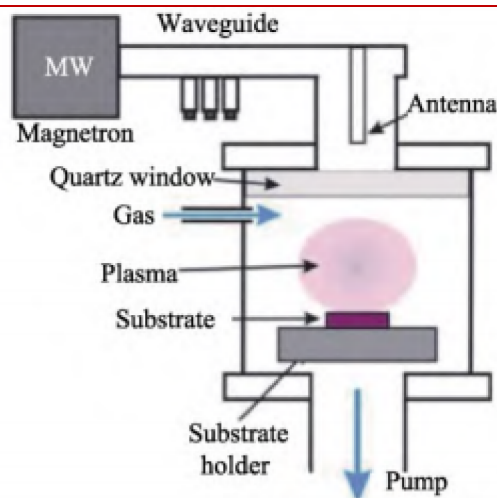
其中, CVD 又常用热丝 HFCVD 和微波等离子 MPCVD 两种加工方式, 前者加工效率高且能制作出面积更大的产品, 后者生成的晶体品质优于前者, 高温高压法。热丝化学气相沉积 (HFCVD) 通过电阻加热钨丝至 $2000\sim 2500^{\circ}\text{C}$, 利用热辐射直接裂解气体分子 (如 CH_4 、 H_2) 生成活性自由基; 微波等离子体化学气相沉积 (MPCVD) 则以微波电磁场激发气体电离形成高密度非平衡等离子体, 可避免电极污染, 适用于金刚石等高质量晶体生长。

图表8: HFCVD 加工方法



资料来源：半导体在线，中邮证券研究所

图表9: MPCVD 加工方法



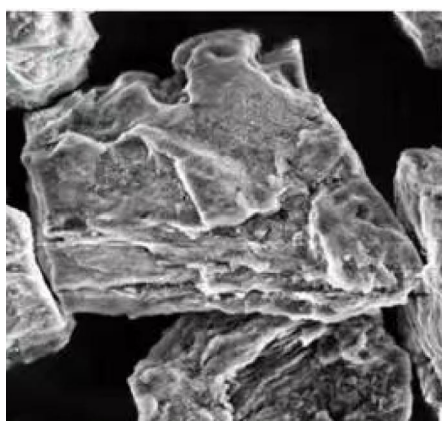
资料来源：半导体在线，中邮证券研究所

单晶金刚石的高导热特性, 使其在高端电子器件散热中极具吸引力, 在 AI 数据中心、激光器热沉、高功率器件、微波器件等领域有着广阔的应用潜力。虽然单晶金刚石性能卓越, 但要大规模应用仍有难点: 如高质量单晶金刚石价格昂贵, 限制了大面积应用; 制备尺寸受限, 难以覆盖大面积散热需求; 金刚石与金属或半导体的接触界面传热效率可能成为瓶颈, 需要特殊界面处理。简而言之, 虽然单晶金刚石是“性能之王”, 但在成本、加工和界面工程上仍需不断突破。

(2)多晶金刚石

多晶金刚石由众多细小的纳米级小颗粒聚集而成，晶体结构不均匀，排列无序，位向不一致，颗粒间通过不饱和键结合，存在明显的晶界，韧性好。多晶金刚石晶界会散射声子，导致热导率降低，其热导率通常在 $1000\sim 1800\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ ，可通过调控晶界结构优化热导率范围，虽然热导率不如单晶金刚石，但也远优于其他材料，更适合作为半导体器件的经济型散热材料。

图表10：多晶金刚石图片



资料来源：超硬材料与磨具磨料，万磨金刚石，中邮证券研究所

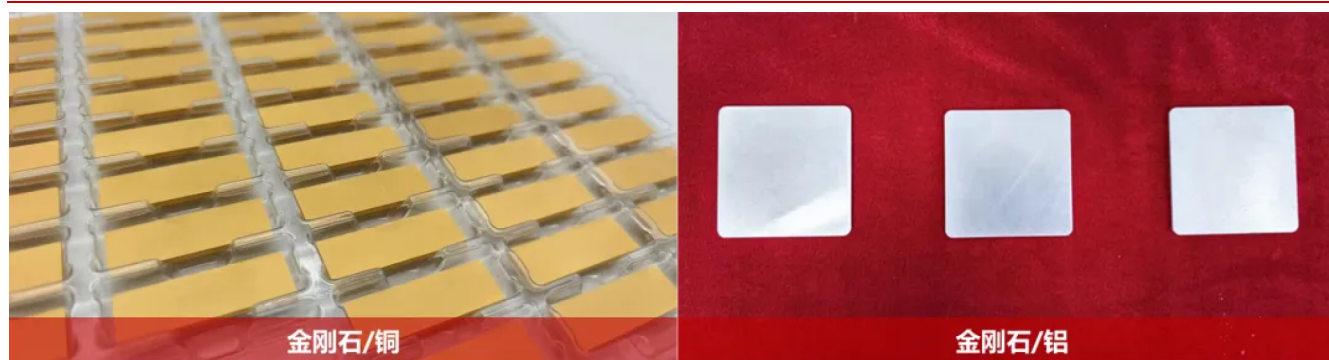
(3)复合路线：金刚石-铜；金刚石-铝复合材料

金刚石-Cu 复合材料通过在铜基体中引入高导热金刚石颗粒，实现了高导热与良好加工性的平衡，典型导热率可达 $600\sim 700\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ ，同时热膨胀系数接近 SiC，有利于功率器件封装。金刚石/Cu 复合材料不仅显著提升导热性能，降低器件结温，还具备良好的加工性，可切割、焊接和机械加工，适合封装和散热器件。目前常用的金刚石/铜复合材料的制备工艺主要包括高温高压法，真空热压烧结法，熔体浸渗法，放电等离子烧结法等。金刚石/Cu 复合材料在芯片散热、高功率半导体封装、激光器及光通信模块热沉、航空航天高端微电子散热结构件等领域具有广泛应用，但界面热阻和成本仍是产业化的关键挑战。

金刚石铝则偏向轻量化和高导热结合，通过在铝基体中引入金刚石颗粒，实现了高导热、轻量化和良好加工性，典型导热率约 $500\sim 600\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$ 。相比金刚石-铜，其密度更低，适合航空航天、便携式高功率电子设备等对重量敏感的应用，同时

通过调节金刚石含量可匹配器件材料的热膨胀系数。工业上主要通过粉末冶金法，将金刚石粉末与铝粉混合高温压制烧结，或采用熔融浸渍法将铝液浸入金刚石骨架形成复合材料。粉末冶金法可以灵活调控含量，实现导热和膨胀优化，而熔融浸渍法则可获得界面热阻更低、导热更均匀的复合材料。金刚石-铝复合材料在航空航天电子散热、便携式高功率电子模块以及光通信模块和激光器热管理中展现出广阔应用前景，但界面润湿性、热稳定性和成本仍是制约大规模应用的关键因素。

图表11：金刚石复合材料



资料来源：DT 半导体，中邮证券研究所

(4)封装基板散热新星——金刚石/SiC 复合基板

电子封装基板是芯片对外散热的直接通道，其导热能力直接决定了封装整体的散热性能。自集成电路诞生以来，半导体器件不断向大功率、高频率、微型化、轻量化、低成本和高可靠性方向发展，随之而来的高热流密度对封装基板提出了更高的导热要求。传统的铜基或陶瓷基板在面对现代功率半导体和高密度芯片时，往往难以兼顾高导热性与热膨胀匹配性，这就为金刚石/SiC 复合基板的应用提供了广阔空间。

金刚石/碳化硅复合材料因其高导热、热膨胀系数匹配、密度低、稳定性好等特点，被认为是理想的电子封装材料。但由于制备困难、成本高、工艺不成熟，目前仍无法实现大规模应用。尤其是现有工艺难以直接制备满足封装基板要求的大尺寸、薄厚度的高导热金刚石/SiC 复合材料，同时其高硬度和脆性也几乎无法通过后期机械加工满足精密尺寸要求。

2025 年，CoherentCorp 推出一款金刚石/碳化硅陶瓷复合材料，专为人工智能数据中心和高性能计算系统的先进热管理设计。这款专利材料热导率超过

800W/（m*k），性能是铜的两倍，同时与硅的热膨胀特性相匹配，主要应用于芯片散热、微通道冷板和半导体器件基板，为高密度电子器件提供高效可靠的散热解决方案。

1.3 潜在市场空间广阔，相关上市公司积极布局

IDTechEx 最新发布的《2025-2035 年数据中心与云端 AI 芯片技术、市场及预测》研究报告指出，到 2030 年，人工智能数据中心的广泛部署、AI 技术的商业化应用以及大型 AI 模型持续提升的性能需求，将推动 AI 芯片市场规模达到 4530 亿美元，若假定人民币汇率为 6.5，对应市场规模接近 3 万亿人民币。

AI 芯片领域，钻石散热潜在市场空间广阔。假设 2030 年全球 AI 芯片市场规模为 3 万亿人民币；AI 芯片中钻石散热方案渗透率分别为 5%、10%、20%、50%；钻石散热价值量占比分别为 5%、8%、10%，进行弹性测算，钻石散热市场空间的区间为 75 亿至 1500 亿。

图表12：AI 芯片领域钻石散热市场空间弹性测算表

单位（亿元）		渗透率			
		5%	10%	20%	50%
价值量占比	5%	75	150	300	750
	8%	120	240	480	1200
	10%	150	300	600	1500

资料来源：IDTechEx，中邮证券研究所

图表13：钻石散热相关上市公司介绍

公司名称	相关业务描述
国机精工	公司 2015 年开始布局金刚石功能化应用方向，选择 MPCVD 法作为技术路线，该路线的优点一是生成的金刚石片品质高，二是兼容性强，MPCVD 路线兼容的产品线范围较多，可生长散热片、光学窗口片及未来合成半导体芯片材料。公司自 2023 年开始在散热和光学窗口实现部分收入，2025 年有望超过 1000 万元，目前应用领域主要聚焦，民用领域处于国内头部厂商进行产品测试阶段，如果进展顺利，预计 2026 年可实现测试结
沃尔德	公司在 CVD 金刚石的制备及应用方面已有多年的研发和技术储备，是少数能够全部掌握 CVD 金刚石生长技术的公司之一，拥有河北省 CVD 金刚石功能材料科技创新中心、廊坊市 CVD 金刚石生长技术研发中心等自主研发平台。
四方达	公司是国内设备规模优势明显的 CVD 金刚石厂商，拥有自主知识产权的 MPCVD 合成及加工设备技术和 CVD 金刚石生长工艺技术，目前已具备批量制备大尺寸（12 英寸）金刚石衬底及薄膜的相关生产能力。
力量钻石	公司已投产的半导体散热材料项目产品，主要应用于高功率半导体材料的散热，在 AI 芯片、新能源等领域有广泛的应用前景
惠丰钻石	公司散热产品主要分为 CVD 金刚石单晶、CVD 金刚石多晶、金刚石复合材料、粉末填料，目前处于下游应用研究中，尚未形成收入。

资料来源：iFind，中邮证券研究所

2 风险提示

钻石散热产业进展不及预期。

中邮证券投资评级说明

投资评级标准	类型	评级	说明
报告中投资建议的评级标准： 报告发布日后的 6 个月内的相对市场表现，即报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数、可转债价格）的涨跌幅相对同期相关证券市场基准指数的涨跌幅。 市场基准指数的选取：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；可转债市场以中信标普可转债指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	预期个股相对同期基准指数涨幅在 20%以上
		增持	预期个股相对同期基准指数涨幅在 10%与 20%之间
		中性	预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与 10%之间
		回避	预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%以下
	行业评级	强于大市	预期行业相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与 10%之间
		弱于大市	预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%以下
	可转债评级	推荐	预期可转债相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		谨慎推荐	预期可转债相对同期基准指数涨幅在 5%与 10%之间
		中性	预期可转债相对同期基准指数涨幅在-5%与 5%之间
		回避	预期可转债相对同期基准指数涨幅在-5%以下

分析师声明

撰写此报告的分析师（一人或多人）承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。

本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息，并通过独立判断并得出结论，力求独立、客观、公平，报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等利益相关方的干涉和影响，特此声明。

免责声明

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务的资格。

本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价，中邮证券不对因使用本报告的内容而导致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，中邮证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

中邮证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者计划提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。

《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告仅供中邮证券签约客户使用，若您非中邮证券签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司不会因接收人收到、阅读或关注本报告中的内容而视其为签约客户。

本报告版权归中邮证券所有，未经书面许可，任何机构或个人不得存在对本报告以任何形式进行翻版、修改、节选、复制、发布，或对本报告进行改编、汇编等侵犯知识产权的行为，亦不得存在其他有损中邮证券商业性权益的任何情形。如经中邮证券授权后引用发布，需注明出处为中邮证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节或修改。

中邮证券对于本申明具有最终解释权。

公司简介

中邮证券有限责任公司，2002年9月经中国证券监督管理委员会批准设立，是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司。

公司经营范围包括：证券经纪，证券自营，证券投资咨询，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，证券承销与保荐，代理销售金融产品，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。

公司目前已经在北京、陕西、深圳、山东、江苏、四川、江西、湖北、湖南、福建、辽宁、吉林、黑龙江、广东、浙江、贵州、新疆、河南、山西、上海、云南、内蒙古、重庆、天津、河北等地设有分支机构，全国多家分支机构正在建设中。

中邮证券紧紧依托中国邮政集团有限公司雄厚的实力，坚持诚信经营，践行普惠服务，为社会大众提供全方位专业化的证券投、融资服务，帮助客户实现价值增长，努力成为客户认同、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。

中邮证券研究所

北京

邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com
地址：北京市东城区前门街道珠市口东大街17号
邮编：100050

上海

邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com
地址：上海市虹口区东大名路1080号邮储银行大厦3楼
邮编：200000

深圳

邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com
地址：深圳市福田区滨河大道9023号国通大厦二楼
邮编：518048